



ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

STRUTTURA DI ROMA II

Roma, 7 luglio 2016
Via della Ricerca Scientifica, 1
00133 – Roma (Italia)

Avviso per manifestazione di interesse per

la produzione e fornitura di un Chip $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ su wafer Si/SiO₂ composto da Josephson Junctions con 2 Nb Wiring Layers da realizzarsi su nostro disegno e secondo nostre specifiche mediante procedura negoziata, previa consultazione, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Operatori Economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento.

1. OGGETTO DELL'AVVISO

La struttura di Roma Tor Vergata dell'INFN intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la fornitura di un Chip $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ su wafer Si/SiO₂ composto da Josephson Junctions con 2 Nb Wiring Layers da realizzarsi su nostro disegno con le specifiche come da capitolato tecnico.

Determina del Direttore n. 16 del 5 luglio 2016.

Importo presunto: € 7500 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.

CIG: Z7E1A8985F

2. REQUISITI

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n.501201.6. I soggetti interessati a partecipare:

- non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1,2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016

3. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d'interesse a essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire entro il **22 luglio 2016** la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la manifestazione d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva.

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto: "*Manifestazione d'interesse per l'affidamento di produzione di un Chip $0.5 \times 0.5 \text{ cm}^2$ su wafer Si/SiO₂ composto da Josephson Junctions con 2 Nb Wiring Layers da realizzarsi su nostro disegno e secondo nostre specifiche – CIG Z7E1A8985F*" mediante PEC al seguente indirizzo PEC roma2@pec.infn.it





ISTITUTO NAZIONALE
DI FISICA NUCLEARE

STRUTTURA DI ROMA II

Roma, 7 luglio 2016
Via della Ricerca Scientifica, 1
00133 – Roma (Italia)

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore della Sezione INFN di Roma Tor Vergata.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Dott. Andrea Salamon (Tel. +39-06-7259-4110, Mail andrea.salamon@roma2.infn.it).

Il Responsabile del Procedimento

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Salamon', is written in a cursive style.

